

## TX4166X 系列恒压恒流 BUCK 控制器

### 1. 特性

- 宽输入电压范围 8~150V
- 输出电压 5V 到 36V 可设置
- 支持软启动
- 逐周期限流保护
- 转换效率>96%
- 恒压恒流输出
- 支持可设置线损补偿
- 低待机功耗
- 内置 40VLDO 供电
- 恒压精度≤±3%
- 过温保护
- 输出短路保护
- 封装: SOT23-5/ESOP8

## 2. 应用领域

- 电动车,电瓶车,扭扭车
- 车充,卡车车充
- MCU 模块供电
- 锂电充放

## 4. 芯片选型

### 3. 说明

TX4166X是一系列外围电路简洁的宽输入电压降压 BUCK 恒压恒流驱动器,适用于 8-150V 输入电压范围的 DCDC 降压应用。

TX4166X 采用我司专利算法,实现高精度的降压恒压恒流。

输出电压通过 FB 管脚设置,输出电流通过 CS 电阻设置,外围简洁,具备高效率,低功耗,低纹波,优异的线性调整率和负载调整率等优点。

支持输出线损补偿,对于充电器方案开发更灵活方便。

TX4166X 采用固定频率 PWM 峰值电流模式,工作频率 为 150KHz,轻载时降频以提高轻载的效率。

芯片支持软启动,输出短路保护,逐周期限流保护,过温保护,提高系统的可靠性。

型号	输出电流范围	驱动方式	封装形式	编带数量(颗/盘)	最高耐压
TX41660	≤10A	外置 MOS	SOT23-5	3000	随 MOS
TX41661	≤2A	内置 MOS	ESOP8	4000	100V
TX41662	≤3A	内置 MOS	ESOP8	4000	60V
TX41663	≤1.5A	内置 MOS	ESOP8	4000	150V



# 5. 管脚配置

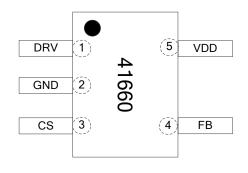
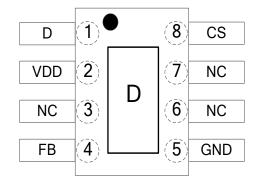


图 5.1 TX41660 管脚图

编号	管脚名称	功能描述
1	DRV	功率 MOS 管 Gate 端
2	GND	芯片地
3	CS	电流检测
4	FB	输出电压采样
5	VDD	供电输入



(EP 管脚为底部散热盘) 图 5.2 TX41661/2/3 管脚图

编号	管脚名称	功能描述
1,EP	D	内置功率 MOS 管 Drain 端
2	VDD	供电输入
4	FB	输出电压采样
5	GND	芯片地
8	CS	电流检测
3,6,7	NC	

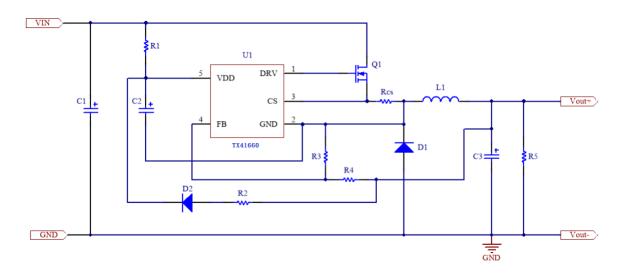


# 6. 极限工作参数

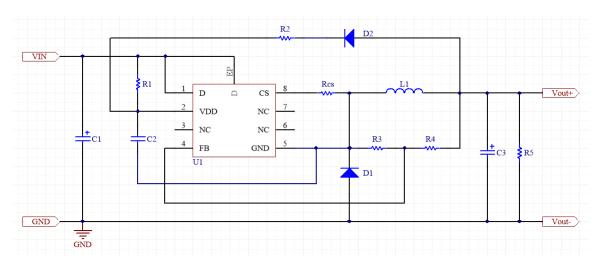
符号	说明	范围	单位
VDD	供电输入	-0.3~40	V
CS	CS 管脚耐压	-0.3~40	V
D(TX41661)	内置功率 MOS 管 Drain 端	-0.3~100	V
D(TX41662)	内置功率 MOS 管 Drain 端	-0.3~60	V
D(TX41663)	内置功率 MOS 管 Drain 端	-0.3~150	V
FB	输出电压采样	-0.3~6	V
TSTG	存储温度	-40~150	°C
TA	工作温度	-40~125	°C
ESD	HBM 人体放电模式	>2	KV



## 7. 应用电路



TX41660 典型应用电路



TX41661/2/3 典型应用电路



# 8. 电气特性

(除非特殊说明,下列条件均为  $T_A$ =25℃)

₩. II	说明	Amil A In And Jol.	范围			34 th
符号		测试条件	最小	典型	最大	单位
VIN 工作部分						
$I_{\mathrm{DD}}$	工作电流	V <sub>IN</sub> =6.5V	-	1	-	mA
I <sub>START</sub>	启动电流		10	-	-	uA
$V_{DD}$	V <sub>DD</sub> 电压范围		6.5	-	24	V
Uup	启动电压			6.2		V
U <sub>VLO</sub>	欠压保护电压			3.5		V
恒压恒流工作部	部分					
$V_{CS}$	限流电压	$V_{IN}=6.5V$	-	-	400	mV
$V_{REF}$	电流检测基准电压		-	200	-	mV
$V_{FB}$	输出采样基准电压		-	1.2	-	V
I <sub>CABLE</sub>	线损补偿电压	FB 下拉电流	-	5	-	uA
震荡器						
$D_{MAX}$	最大占空比		-	90	-	%
F <sub>osc</sub>	开关频率	VIN=24,VOUT=12V, IOUT=1A	-	150	-	KHz
GATE 驱动						
$I_{H}$	驱动上拉电流		-	400	-	mA
I <sub>I</sub>	驱动下拉电流		-	600	-	mA
可靠性						
$T_{OVT}$	过温保护	输出关闭	-	142	-	°C

### 备注:

- 1. 对于未给定上下限值的参数,本规范不保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
- 2. 规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。



### 9. 应用说明

TX4166X 是一款外围电路简洁的宽输入电压范围的降压 BUCK 恒压恒流驱动器,支持输入电压高达150V。芯片采用本司专利算法,采用固定工作频率,PWM 峰值电流模式从而达到高精度的恒压恒流,高效率,低功耗,低纹波,以及优异的线性调整率和负载调整率。

#### 9.1. 芯片启动

系统上电后通过启动电阻 R1 对连接于 VDD 引脚的电容充电,启动电流最小需要 10uA; 当 VDD 电压高于 6.5V 后,芯片开始工作, VDD 最大钳位电压 24V。

当芯片功率 MOS 管关闭时,R2、D2 对芯片 VDD 供电,24V 以下输出时 R2 的建议值为  $22\Omega$  ,24V 以上输出时适当增大 R2 电阻。D2 选择反向额定电压大于输入电压的肖特基二极管。

#### 9.2. 设置输出电压

输出电压通过 FB 管脚的分压电阻 R3、R4 设置,其公式如下:

$$V_{OUT} = V_{FB} \times \left(\frac{R3 + R4}{R3}\right)V$$

其中 V<sub>EB</sub> 为输出采样基准电压,典型值为 1.2V。

为了提高输出电压的精度,PCB布局R3、R4分压电阻紧靠着FB管脚。

#### 9.3. 设置最大输出电流

最大输出电流通过 CS 对 GND 管脚的电阻设置,公式如下:

$$I_{OUT\_MAX} = \frac{0.2V}{R_{CS}} A$$

其中 I<sub>OUT MAX</sub> 为最大输出电流, R<sub>CS</sub> 为系统的检流电阻。

#### 9.4. 电感选择

电感的选择可通过计算公式算出:

$$L = \frac{(V_{IN} - V_{OUT}) \times V_{OUT} \times 10^{6}}{r \times I_{OUT \text{ MAX}} \times f \times V_{IN}} (uH)$$

 $V_{\mathrm{IN}}$ : 输入电压, $V_{\mathrm{OUT}}$ : 输出电压, $I_{\mathrm{OUT\ MAX}}$ : 最大输出电流,r: 电流纹波率,f: 工作频率。

举例:  $V_{IN}=24V$ 、 $V_{OUT}=5V$ 、 $I_{OUT\_MAX}=2A$ 、f=150kHz、r=0.35,代入公式计算得电感 L $\approx$ 43.5uH,选用 47uH。

电感的选择影响功率、效率、稳态运行、瞬态行为和回路的稳定性。电感值决定了电感的纹波电流。 选用电感需要注意其额定饱和电流以及 DCR, DCR 过大会降低效率。



电感典型值在33~100uH之间,选取大的电感值,电感的纹波电流会变小,有助于提高效率。

电感平均电流计算公式:

$$I_{AVG} = I_{OUT}(A)$$

电感峰峰值电流计算公式:

$$I_{PP} = \frac{V_{OUT}}{L \times f} \times (1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}) (A)$$

电感峰值电流计算公式:

$$I_{PK} = I_{OUT} \times (1 + \frac{r}{2})(A)$$

#### 9.5. 续流二极管选择

注意续流二极管的额定平均电流应大于流过二极管的平均电流。二极管平均电流计算公式如下:

$$I_{D} = I_{OUT} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right) (A)$$

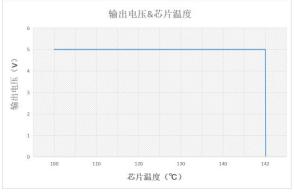
注意,二极管应具有承受反向峰值电压的能力同时反向额定电压大于 VIN 的二极管。为了提高效率,选择肖特基二极管。

### 9.6. VDD 旁路电容选择

为了保持电路的稳定, VDD 管脚对芯片地需要并联一个 10uF 以上的旁路电容,输出负载越大需要的容量越大。PCB 布板时, VDD 旁路电容需要紧挨着芯片管脚布局。

#### 9.7. 过温处理

当芯片温度过高时(典型情况下是芯片内部温度达到 142℃以上时),系统会关断功率管,直接关闭输出,从而限制输入功率,增强系统可靠性;当芯片内部温度降低,退出过温保护后,芯片恢复正常重新启动工作。

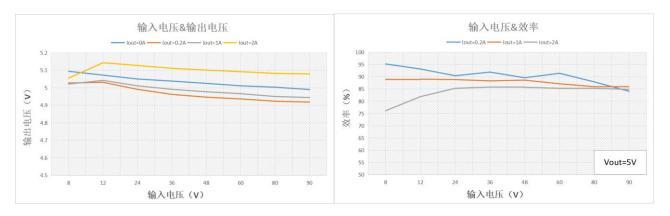




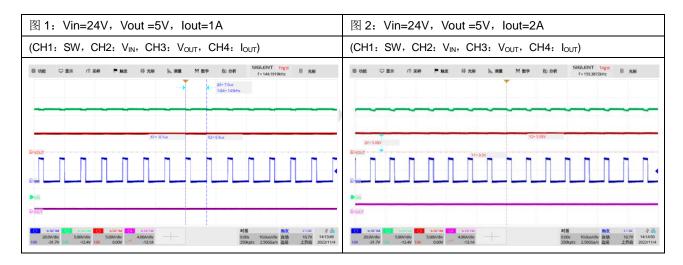
## 10. 典型特性曲线

测试条件: V<sub>IN</sub>=8~90V; V<sub>OUT</sub>=5V; I<sub>OUT</sub>=0~2A; R1=100K; R2=22R; R3=31K; R4=110K; R5=2K; L=68uH; C1=47uF/100V; C2=10uF/50V; C3=220uF/50V×2; Rcs=0.2R×3; D1=510(SMB); D2=SS110(SMA);

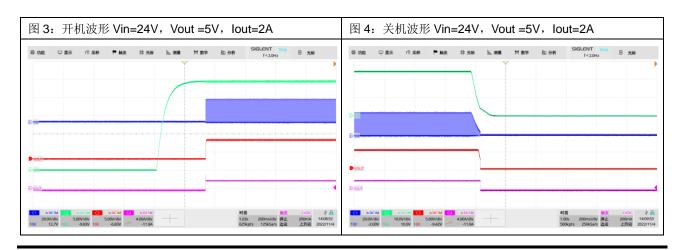
#### 10.1. 典型曲线



#### 10.2. 稳态波形

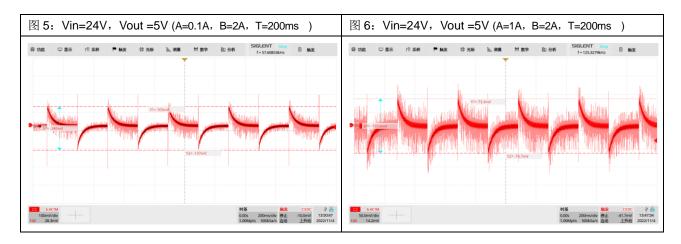


### 10.3. 开关机波形

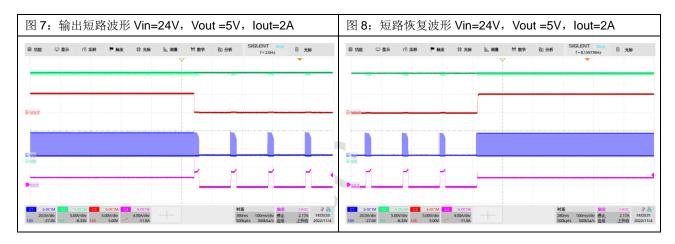




#### 10.4. 动态响应波形



#### 10.5. 输出短路波形



## 11. PCB 设计注意事项

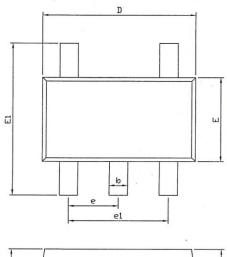
一个好的 PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 TX4166X 系统 PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:

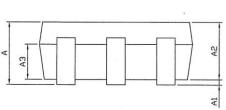
- 1. 减小开关电流的环路面积,减小由输入端、芯片&MOS D 端、续流二极管与功率电感形成的 环路面积;
- 2. 芯片 FB 管脚为敏感节点,远离功率电感、芯片&MOS D 端、续流二极管等大电流线路,避免受到干扰;
- 3. 检流电阻 Rcs 要靠近芯片 CS 和 GND 管脚、续流二极管和功率电感,走线尽可能短且宽, 在兼顾散热情况下,减小环路面积,降低 EMI 辐射;
- 4. 系统的输入输出电容靠近芯片布局,可有效减小输入噪声和输出纹波,达到最好的滤波效果,提高系统性能;
- 5. 芯片的 VDD 电容靠近芯片管脚与 GND 管脚布局,且 VDD 电容的 GND 端、芯片 GND 端与 CS 峰值电流检测电阻 GND 端保持单点连接;
- 6. 在输出端并联一个假负载,反馈回路更稳定。

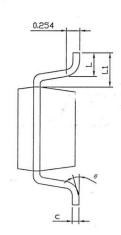


# 12. 封装信息

# **SOT23-5:**





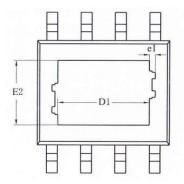


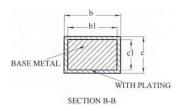
Cumbal.	Dimensions I	n Millimeters	
Symbol	Min	Max	
` A		1,35	
* A1	0.04	0.12	
A2	1.00	1,20	
A3	0.55	0.75	
b	0.37	0.43	
C	0.11	0.21	
* D	2.77	3.07	
E	1.40	1,80	
* E1	2.70	3.00	
e /; ,	0.90	1.00	
* e1	1.80	2.00	
L	0,35	0.55	
* L1	0,55	0.75	
θ	0°	8°	

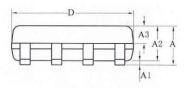
注:1. 标注"\*"尺寸为测量尺寸。

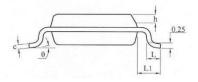


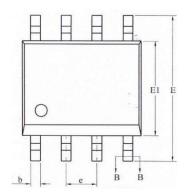
# ESOP8:











CVMDOI	MILLIMETER			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX	
A			1.65	
Al	0.05	_	0.15	
A2	1.30	1.40	1.50	
A3	0.60	0.65	0.70	
b	0.39		0.47	
b1	0.38	0.41	0.44	
c	0.20		0.24	
c1	0.19	0.20	0.21	
D	4.80	4.90	5.00	
Е	5.80	6.00	6.20	
E1	3.80	3.90	4.00	
e	1.27BSC			
h	0.25	_	0.50	
L	0.50	0.60	0.80	
L1	1.05REF			
θ	0		8°	

Size (mm) L/F Size (mil)	D1	E2	el
95*130	3.10REF	2.21REF	0.10REF